(12)特許協力条約に基づいて公開された国際内

(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



10/541965

(43) 国際公開日 2004年7月29日(29.07,2004)

PCT

(10) 国際公園番長 WO 2004/062868 A1

(51) 国際特許分類7: B28D 5/00, C03B 33/09 (21) 国際出頭番号: PCT/TP2004/000084 (22) 国際出頭日: 2004年1月8日(08.01.2004) (25) 国際出頭の言語:

(26) 国際公開の言語・

特願2003-004282

(30) 優先権データ:

(72) 発明者: および

日本語

日本語

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 藤井 昌宏 (FU.III. Masahiro) [JP/JP]; 〒5640044 大阪府吹田市南金田2丁 目12番12号 三星ダイヤモンド工業株式会社内 Osaka (JP).

(74) 代理人: 岡本 宜喜 (OKAMOTO, Yoshiki); 〒5770066 大阪府東大阪市高井田本通7丁目7番19号昌利 ビル 安田岡本特許事務所内 Osaka (JP).

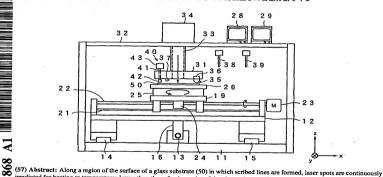
(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が 可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA. NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE,

2003年1月10日(10.01.2003)

(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 三星ダ イヤモンド工業株式会社 (MITSUBOSHI DIAMOND INDUSTRIAL CO., LTD.) [JP/JP]; 〒5640044 大阪府吹 田市南金田2丁目12番 1 2号 Osaka (IP)

(54) Title: BRITTLE MATERIAL SUBSTRATE SCRIBING DEVICE AND SCRIBING METHOD, AND AUTOMATIC ANAL-YSIS LINE

(54)発明の名称: 脆性材料基板のスクライブ装置及びスクライブ方法並びに自動分断ライン



irradiated for heating to temperatures lower than the softening point of the glass substrate (50), and the neighboring region is cooled. Thereby, a blind crack is formed along a scribing-scheduled line. A detection unit (40) radiates light toward the blind crack immediately after the formation thereof in the vicinity of the cooling spot, through an optical fiber (41). If a blind crack has been formed, this will result in a part of the light being obtained in the optical fiber (41) by diffused reflection. Therefore, whether or not the blind crack is normally detected is ascertained by detecting the level of this reflected light.

(57)要約:ガラス基板50の表面におけるスクライブラインが形成される領域に沿って、ガラス基板50の軟化点 よりも低い温度でレーザスポットを連続して照射して加熱し、その近傍の領域を冷却する。これ

[続葉有]

SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ. VC, VN, YU. ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限リ、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, 2M, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BR, KG, KZ, MD, RU, TI, TIM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, ET, LU, MC, NI., PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BP, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG)

添付公開書類: 一 国際調査報告書 一 補正書・説明書

2文字コード及び他の路語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

によりスクライブ予定ラインに沿ってブラインドクラックを形成する。検出ユニット40は光ファイバ41を介して光を冷却スポット近傍で形成された直後のブラインドクラックに向けて照射する。ブラインドクラックが形成されていれば、乱反射により一部の光が光ファイバ41に得られる。従ってこの反射光のレベルを検出することによってブラインドクラックが正常に検出されているかどうかを確認する。

明細書

脆性材料基板のスクライブ装置及びスクライブ方法並びに自動分断ライン

5 技術分野

本発明は、フラットパネルディスプレイ(以下、FPDという)に使用されるガラス基板、半導体ウェハ等の脆性材料にスクライブラインを形成する際に使用されるスクライブ装置とスクライブ方法、及びこれを用いた自動分断ラインに関するものである。

背景技術

10

25

一対のガラス基板を貼り合わせたFPDは、夫々が大寸法のマザーガラス同士を相互に貼り合わせた後に、所定の大きさになるように分断されて製造される。貼り合わされたマザーガラスを分断する際には、まずスクライブ装置を備えたスクライブ工程において、夫々のマザーガラスにあらかじめカッターによってスクライブラインが形成され、次に、そのスクライブラインが形成されたマザーガラスをブレイク工程へ搬送して、スクライブライン直下の垂直クラックをマザーガラスの厚み方向へ浸透させる(プレイクさせる)。すなわち、ガラス基板の分断工程は、スクライブ工程とそのスクライブ工程の後に設けられるプレイク工程で構成される。

近年、スクライプ工程において、日本特許第3027768号にも示されているように、スクライプラインを形成するためにレーザビームを使用する方法が実用化されている。レーザビームを使用してガラス基板にスクライプラインを形成する方法では、第1図に示すように、ガラス基板111に対してレーザ発振装置112からレーザビームが照射される。レーザ発振装置1

25

12から照射されるレーザビームは、スクライプ予定ラインに沿って楕円形状のレーザスポットLSをガラス基板111上に形成する。ガラス基板11 1とレーザ発振装置112から照射されるレーザビームは、レーザスポットの長手方向に沿って相対的に移動させられる。

また、ガラス基板 1 1 1 の表面におけるレーザビームの照射領域の近傍には、スクライブラインが形成されるように、冷却ノズル 1 1 3 から冷却水等の冷却媒体が吹き付けられるようになっている。レーザビームが照射されるガラス基板 1 1 1 の表面には、レーザビームによる加熱によって圧縮応力が生じた後に、冷却媒体が吹き付けされることにより引っ張り応力が生じる。

このように圧縮応力が生じた領域に近接した領域に引っ張り応力が生じるために、両領域間に夫々の応力に応じた応力勾配が発生し、ガラス基板111 には、ガラス基板111の端部に形成されたプラインドクラック(垂直クラック)を生成させるため、切り目(トリガー)からスクライブ予定ラインに沿ってブラインドクラック(垂直クラック)が形成されていく。

15 このようにしてレーザビームでガラス基板111の表面に形成される垂直 クラックは微小なため、通常、肉眼では目視することができないので、ブラ インドクラックBCといわれている。

スクライブラインとしてのブラインドクラック(垂直クラック)BCをガラス基板111に形成すると、ガラス基板111を次のプレイク工程に搬送させて、プラインドクラックBCの幅方向に曲げモーメントが作用するようにガラス基板に力を加え、垂直クラックをガラス基板の厚み方向に浸透させることにより、ガラス基板111はスクライブラインであるブラインドクラックBCに沿って分断される。

このようなスクライブ装置では、レーザビームによる単位面積当りの照射 エネルギーによる加熱、冷却媒体による冷却、レーザビームとガラス基板と の相対的な移動速度等の条件設定が適切でない場合には、ブラインドクラッ クBCが正常に形成されない場合がある。ガラス基板にブラインドクラック BCが正常に形成されずにガラス基板が次のプレイク工程に供給されると、ガラス基板はプラインドクラックBCに沿って分断されず、ガラス基板が破損してしまう。このように、プレイク工程においてガラス基板が破損すると、FPDの部品として使用することができず、経済性が損なわれると共に、FPDの生産効率も低下することになる。又ガラス基板の破損によって、ガラス基板を分断するための装置自体が破損する恐れもある。

このために、スクライブ装置において、ガラス基板にプラインドクラック BCが確実に形成されていることを確認することが望ましい。しかしながら、 ガラス基板内に形成されるプラインドクラックBCは微小であって、通常、

10 目視すること及びCCDカメラにより直接的に観察することができない。そのためスクライブ装置において、プラインドクラック(垂直クラック)BCが正常に形成されていることを確認することは容易でないという問題があった。

又レーザから照射されるレーザビームの影響を目に受ける危険性があるの で、スクライブ途中のレーザビームの照射中に目視でプラインドクラックの 形成を確認するには安全面上の問題もあった。

本発明はこのような問題を解決するものであり、ガラス基板等の脆性材料 基板の表面に形成されるプラインドクラックの形成状況を確実に確認して、 脆性材料基板のプレイク工程において脆性材料基板を確実に分断することが できる脆性材料基板のスクライブ装置とスクライブ方法、及びこれを用いた 自動分断ラインを提供することを目的とする。

発明の開示

20

本発明の脆性材料基板のスクライブ装置は、脆性材料基板の表面における 25 スクライブ予定ラインに沿って、該脆性材料基板の軟化点よりも低い温度で 連続して加熱しつつ、その加熱領域の近傍の領域を連続して冷却することに より、前記スクライブ予定ラインに沿ってプラインドクラックを形成する脆

15

性材料基板のスクライブ装置であって、前記脆性材料基板の表面における冷却領域に近接したプラインドクラックの形成領域との間で光が伝播されるように配置された導光路と、前記導光路を介して光を出射する投光部と、前記投光部から前記導光路を介して出射されブラインドクラックによって反射された光を前記導光路を介して受光する受光部と、前記受光部より得られた受光レベルを判別する判別部と、を具備することを特徴とするものである。

又このような少なくとも1台の脆性材料基板のスクライブ装置と、少なくとも1台のプレイク装置を備えて脆性材料基板の自動分断ラインを構成する。本発明の脆性材料基板のスクライブ装置は、脆性材料基板の表面におけるスクライブ予定ラインに沿って、該脆性材料基板の軟化点よりも低い温度で連続して加熱しつつ、その加熱領域の近傍の領域を連続して冷却することにより、前記スクライブ予定ラインに沿ってブラインドクラックを形成する脆性材料基板のスクライブをラインに沿ってブラインドクラックを形成する脆性材料基板のスクライブ装置であって、前記脆性材料基板の表面における冷却領域に近接したブラインドクラックの形成領域との間で光が伝播されるように配置された第1,第2の導光路と、前記第1の導光路を介して光を出射する投光部と、前記投光部から前記導光路を介して出射されブラインドクラックを透過した光を前記第2の導光路を介して受光する受光部と、前記受光部より得られた受光レベルを判別する判別部と、を具備することを特徴とするものである。

又このような少なくとも1台の脆性材料基板のスクライブ装置と、少なくとも1台のプレイク装置を備えて脆性材料基板の自動分断ラインを構成する。本発明の脆性材料基板のスクライブ方法は、脆性材料基板の表面におけるスクライブ予定ラインに沿って、該脆性材料基板の軟化点よりも低い温度で連続して加熱しつつ、その加熱領域の近傍の領域を連続して冷却することにより、前記スクライブ予定ラインに沿ってブラインドクラックを形成する脆性材料基板のスクライブ方法であって、前記脆性材料基板の表面における冷却領域に近接したブラインドクラックの形成領域に向けて導光路を介して光

10

20

25

を出射し、ブラインドクラックから得られる反射光を前記導光路を介して受 光し、その受光レベルに基づいてブラインドクラックの形成状態を確認しつ つスクライブすることを特徴とするものである。

本発明の脆性材料基板のスクライブ方法は、脆性材料基板の表面におけるスクライブ予定ラインに沿って、該脆性材料基板の軟化点よりも低い温度で連続して加熱しつつ、その加熱領域の近傍の領域を連続して冷却することにより、前記スクライブ予定ラインに沿ってブラインドクラックを形成する脆性材料基板のスクライブ方法であって、前記脆性材料基板の表面における冷却領域に近接したブラインドクラックの形成領域に向けて第1の導光路を介して光を出射し、ブラインドクラックを透過した光を第2の導光路を介して受光し、その受光レベルに基づいてブラインドクラックの形成状態を確認しつつスクライブすることを特徴とするものである。

図面の簡単な説明

第1図はレーザピームによるスクライブラインの形成方法を説明するため の模式図である。

第2図は本発明の実施の形態による脆性材料基板のスクライブ装置の概略 構成図である。

第3図は本実施の形態によるスクライブ装置によるスクライブライン形成中のガラス基板上のレーザビーム照射位置を模式的に示す斜視図である。

第4図はガラス基板上の物理的変化状態を模式的に示す平面図である。

第5図は本実施の形態の光ファイバセンサからガラス基板に投光された光の反射状態を示す側面図である。

第6図は本実施の形態によるスクライブ装置の検出ユニットのガラス基板 の位置に対する受光光量の変化を示すグラフである。

第7図はスクライブライン形成加工中に発生する制御不能なクラックの例 を示す図である。 第8図は本発明の第2の実施の形態によるスクライブ装置の検出ユニットの検出状態を示す概略図である。

第9図は本発明の第3の実施の形態によるスクライブ装置の概略構成図である。

5 第10図は本発明の実施の形態によるスクライブ装置の検出ユニットの他の例の構成を示す図である。

第11図はスクライブ装置に続けてブレイク装置を組み込んだガラス基板の分断ラインの一例を示すガラス基板自動分断ラインの概略図である。

10 発明を実施するための最良の形態

15

以下、本発明の実施の形態による脆性材料基板のスクライブ装置を図面に基づいて説明する。このスクライブ装置は、例えばFPDに使用されるガラス基板を分断するためのスクライブ工程の一つとして使用される。第2図は本発明の実施の形態を示す概略構成図である。このスクライブ装置は、水平な架台11上に所定の水平方向(Y方向)に沿って往復運動するスライドテーブル12を有している。

スライドテーブル12は、架台11の上面に沿って平行に配置された一対のガイドレール14及び15に、水平な状態で各ガイドレール14及び15に沿ってスライド可能に支持されている。両ガイドレール14及び15の中間部には、各ガイドレール14及び15と平行にボールネジ13がモータ(図示せず)によって回転するように設けられている。ボールネジ13はモータ(図示せず)によって正転及び逆転可能になっており、このボールネジ13にボールナット16は、スライドテーブル12に回転しない状態で一体的に取付けられており、ボールネジ13の正転及び逆転によってボールネジ13に沿って両方向にスライドする。これにより、ボールナット16と一体的に取付けられたス

ライドテープル12が各ガイドレール14及び15に沿ってY方向にスライ

ドする。

2.5

スライドテーブル12上には、台座19が水平な状態で配置されている。 台座19は、スライドテーブル12上に平行に配置された一対のガイドレール21にスライド可能に支持されている。各ガイドレール21は、スライドテーブル12のスライド方向であるY方向と直交するX方向に沿って配置されている。又、各ガイドレール21間の中央部には、各ガイドレール21と平行にボールネジ22が配置されており、ボールネジ22がモータ23によって正転及び逆転されるようになっている。

ボールネジ22には、ボールナット24が螺合する状態で取付けられている。ボールナット24は台座19に回転しない状態で一体的に取付けられており、ボールネジ22の正転及び逆転によって、ボールネジ22に沿って両方向に移動する。これにより、台座19が各ガイドレール21に沿ったX方向にスライドする。

台座19上には回転機構25が設けられており、この回転機構25上に回転テーブル26が水平な状態で設けられている。回転テーブル26上にはスクライブ加工の対象であるガラス基板50が載置される。回転機構25は回転テーブル26を垂直方向に沿った中心軸の周りに回転させるようになっており、基準位置に対して任意の回転角度になるように、回転テーブル26を回転させることができる。回転テーブル26上には、ガラス基板50が、例20 えば吸引チャックによって固定される。

回転テーブル26の上方には、回転テーブル26とは適当な間隔をあけて 支持台31が配置されている。支持台31は垂直状態で配置された光学ホル ダ33の下端部に水平な状態で支持されている。光学ホルダ33の上端部は、 架台11上に設けられた取付台32の下面に取付けられている。取付台32 上にはレーザビームを発振するレーザ発振器34が設けられており、レーザ 発振器34から発振されるレーザビームが光学ホルダ33内に保持された光 学系に限射される。

10

. 15

20

光学ホルダ33内に照射されるレーザビームは、光学ホルダ33の下端面から回転テーブル26上に載置されたガラス基板50に照射される。このとき光学ホルダ33内に保持された光学系によって、所定方向に沿って長く延びる楕円形状のレーザスポットとしてガラス基板50に照射される。

支持台31の下方には、ガラス基板50の表面に切れ目(トリガー)を形成するカッターホイールチップ35が設けられている。このカッターホイールチップ35は、ガラス基板50の端部に照射されるレーザビームの長手方向に沿ってブラインドクラック(垂直クラック)の形成のきっかけとなる切れ目(トリガー)を形成するために用いられ、チップホルダ36によって昇降可能に保持されている。

又支持台31には、光学ホルダ33に近接して、取付位置可変に冷却ノズル37が設けられている。この冷却ノズル37からは、冷却水、Heガス、N2ガス、CO2ガス等の冷却媒体がガラス基板50に噴射されるようになっている。冷却ノズル37から噴射される冷却媒体は、光学ホルダ33からガラス基板50に照射されるレーザスポットの長手方向の端部に近接した位置に吹き付けられる。

又スクライブ装置には、ガラス基板50にあらかじめパターニングされた アライメントマークを撮像する一対のCCDカメラ38及び39が設けられ ており、各CCDカメラ38及び39にて撮像された画像を表示するモニタ 28及び29が取付台32上に夫々設けられている。

支持台31には冷却ノズル37に近接して検出ユニット40が設けられる。 検出ユニット40は冷却ノズル37からガラス基板に吹き付けられる冷却媒 体の近接した領域においてブラインドクラック(垂直クラック)が正常に形 成されているか否かを検出するものである。例えば検出ユニット40には、

25 光電センサが使用され、光電センサは光ファイバ41及び投受光部42、判別部43を含んで構成される。

このようなスクライブ装置によってガラス基板50をスクライブする場合

20

2.5

には、まず所定の大きさに分断されるガラス基板 5 0 をスクライブ装置の回転テーブル2 6 上に載置し、吸引手段によって固定する。そしてCCDカメラ3 8 及び3 9 によって、ガラス基板 5 0 に設けられたアライメントマークを撮像する。撮像されたアライメントマークは、モニタ 2 8 及び 2 9 によって表示され、テーブル位置決め用の画像処理装置(図示せず)でアライメントマークの位置情報が処理される。その後、支持台 3 1 に対して、ガラス基板 5 0 を載置した回転テーブル 2 6 を所定の位置に位置決めし、ガラス基板 5 0 にレーザビームによりスクライブを実施する。ガラス基板 5 0 をスクライブする際には、光学ホルダ 3 3 からガラス基板 5 0 の表面に照射する楕円形状のレーザスボットの長手方向が、ガラス基板 5 0 に形成されるスクライブラインに沿った X 方向となる。回転テーブル 2 6 の位置決めは、スライドテーブル 1 2 上の台座 1 9 のスライド、及び回転機構 2 5 による回転テーブル 2 6 の回転によって行われる。

第3図はスクライブ装置によってスクライブされるガラス基板50上のレ 15 一ザビーム照射状態を示す模式的斜視図で、第4図はそのガラス基板50上 の物理変化状態を模式的に示す平面図である。

回転テーブル26が支持台31に対して位置決めされると、回転テーブル26がX軸方向に沿ってスライドされて、ガラス基板50の端部が、カッターホイールチップ35に対向される。そしてカッターホイールチップ35が下降して、ガラス基板50の端部に切れ目(トリガー)TRを形成する。

その後、回転テーブル26をスクライブ予定ラインに沿ってX方向にスライドしつつ、レーザ発振器34からレーザピームを照射する。そして同時に冷却ノズル37から冷却媒体、例えば冷却水を圧縮エアーと共に噴射する。

レーザ発振器34から発振されたレーザピームは、ガラス基板50の表面に、楕円形状のレーザスポットLSを形成する。レーザスポットLSは、例えば長径りが30.0mm、短径aが1.0mmの楕円形状になっており、長軸が形成すべきスクライブライン方向に一致するように照射される。この

場合、レーザスポットLSによる加熱温度は、ガラス基板50が溶融される温度より低い、即ちガラス基板の軟化点よりも低い温度とされる。これにより、レーザスポットLSが照射されたガラス基板50の表面は、溶融されることなく加熱される。

冷却ノズル37からは、レーザスポットLSが照射される領域に対して、レーザスポットLSの長軸方向に例えば2.5mmの間隔をあけたスクライブ予定ライン上である冷却ポイントCPに、冷却水が吹き付けられる。これにより、ガラス基板50の表面の冷却ポイントCPが冷却される。その結果、レーザスポットLSと冷却ポイントCPとの間の領域に温度勾配が生じる。

10 レーザスポットLSによって加熱されたガラス基板50の表面の領域には、 圧縮応力が発生し、又冷却水が吹き付けられた冷却ポイントCPには、引っ 張り応力が発生する。このようにレーザスポットLSによる加熱領域に圧縮 応力が発生し、冷却水による冷却ポイントCPに引っ張り応力が発生すると、 レーザスポットLSと冷却ポイントCPとの間の熱拡散領域HDに発生して

いる圧縮応力により、冷却ポイントCPに対してレーザスポットLSとは反対側の領域に大きな引っ張り応力が生じる。そしてこの引っ張り応力を利用して、回転テーブル26がスクライブ予定ラインに沿ってX方向にスライドするに伴い、ガラス基板50端部にカッターホイールチップ35により形成された切れ目(トリガー)TRからプラインドクラックBCが、スクライブラテラインに沿って形成される。プラインドクラックが生じた直後には目視が可能であるが、数秒後には観察不能となる。

プラインドクラックBCの深さ(深度) δ は、レーザスポットLSの大きさ、熱拡散領域HDの大きさ、レーザスポットLS及び冷却ポイントCPとガラス基板 5 0 との移動速度Vに依存しており、次の(1)式で表される。

25 但し、aはレーザスポットLSの短径、bはレーザスポットLSの長径、Lは熱拡散領域HDのスクライブラインに沿った長さ(レーザスポットLSと冷却ポイントCPとの間隔)であり、kはスクライブの対象である材料(ガ

25

ラス基板)の熱物性、加熱ビーム照射密度等に依存した係数である。 V=k+a (b+L) $\angle \delta$ ・・・(1)

前述したように、一例としてレーザスポットLSの短径aが1.0mm、レーザスポットLSの長径bが30.0mm、熱拡散領域HDのスクライブラインに沿った長さLが2.5mmであって、ガラス基板50の移動速度が300mm/sec、レーザピームのパワーが80Wの場合には、プラインドクラックBCの深度は120μmになる。これらの数値は、各種加工条件により最適な数値の組み合わせとなるように選択されてスクライブ加工に用いられる。

さて第3図に示すように、レーザスポットLSの直後に冷却ポイントCP 10 があり、その直後に前述したように垂直クラックが生じる。この垂直クラッ クはすぐにプラインドクラックBCとなるために、検出可能な冷却ポイント CPの直後の検出ポイントDPに向けて光電センサの投受光部42より投光 する。そして投光された光は第3図、第5図に示すように、ガラス基板50 の下面で一旦反射し、その反射光がブラインドクラックに照射され、ブライ 15 ンドクラックで光が乱反射され、乱反射した反射光の一部が光電センサの投 受光部42に得られる。光電センサの判別部のフォトダイオードがこの反射 光の光量レベルを電気信号に変換し増幅する。そして所定の閾値で弁別する ことによってスクライブライン(プラインドクラックBCのライン)の状態 20 を検出する。また、光電センサの投受光部42より検出ポイントDPに向け ての投光、ブラインドクラックで乱反射した反射光の受光に導光路が用いら れる。導光路には光ファイバや光導波路フィルムが用いられるが、本願では 導光路の一例として光ファイバを用いて説明する。

第6図(a)はガラス基板50のX方向に沿ったスクライプライン上の位置 Pに対する光ファイバ41に得られるセンサ帰還光量Iの変化を示す図である。正常なスクライブが形成された場合は、ガラス基板50のスクライブを開始したスクライブ開始点付近P1及びスクライブ終了点付近P2のガラ

10

ス基板端部では、センサ光量が図6のI1, I2のように増大するが、その間ではセンサ光量I3はほぼ一定であり、スクライブが正常に形成されていることが確認される。又第7図(a)に示すように、スクライブ予定ラインに沿ってガラス基板の側縁部においてレーザスポットLSの端部によって急激に加熱されると、ガラス基板にはレーザスポットLSの前方に制御不能なクラックが形成されることがある。このような制御不能なクラックは先走りクラックCR1といい、この先走りクラックCR1が生じた場合には、第6図(b)に示すように、その先走り部分で光量レベルI4が高くなる。又第6図(c)に示すように、スクライブラインが形成できなかった場合には反射光が得られないため、センサで検出する光量レベルが零レベルとなる。従ってガラス基板に形成されたブラインドクラックの不良状態を検出することができる。

又第7図(b)に示すように、スクライブの予定ラインに沿ってプライン ドクラックBCを形成し、スクライブ加工終点付近のレーザスポットLSに よって加熱が終了するガラス基板の側縁部においても、レーザスポットLS 15 の端部によって急激に加熱されると、ガラス基板50にはその側縁からレー ザスポットLSの移動方向とは反対方向に向かって制御不能なクラックCR 2 が形成されることがある。このようなクラック CR 2 も制御不能であり、 このクラックCR2が生じても反射光のレベルが高くなる。従って正常な反 射光レベルの上下に所定の閾値レベルVref1. Vref2を設定しておく。 20 反射光のレベルがガラス基板50の端部以外でこの閾値Vref1を超え、又 は反射光のレベルがこの閾値Vref2 以下となる場合は、光電センサの判別 部43は不良状態と識別する。検出ユニット40の一例である光電センサの 判別部43から〇K信号が出力された場合には、ガラス基板50に対するス クライブライン (プラインドクラックBCのライン) の形成作業が継続して 25 行われる。これに対して検出ユニット40の判別部43からNG信号が出力 された場合には、ガラス基板50に対するスクライブライン(プラインドク

15

ラックBCのライン)の形成作業を中断すると共に、後工程にガラス基板 5 0 を送ることを中断するように、作業者に異常発生を知らせる警報を発する。このように、スクライブ加工中において、ガラス基板 5 0 にブラインドクラックBCが良好に形成されない場合には、スクライブ加工が中断されると共に、警報が発せられる。従ってオペレータは、スクライブの形成加工中のガラス基板 5 0 にブラインドクラックBCが正常に形成されていないことを認識することができる。これによりオペレータは、スクライブ装置の回転テーブル 2 6 上のガラス基板 5 0 を不良品として取り除く。従ってブラインドクラックBCが正常に形成されていない不良品であるガラス基板 5 0 は、次

尚第5図ではプラインドクラックBCの左方から光ファイバ41、投受光部42を設けて検出するようにしているが、プラインドクラックの右方から光ファイバ41と投受光部を用いて光を投光してもよく、プラインドクラックの形成予定ラインによって使い分けるものとする。又ガラス基板50の下面に一旦光を反射させてプラインドクラックに入射させずに直接光をプラインドクラックの形成されている位置に入射するようにしてもよい。

のプレイク工程に供給される恐れがない。

次に本発明の第2の実施の形態について説明する。第1の実施の形態では 1本の光ファイバ41を用いて投受光用としているが、投光用の光ファイバ と受光用の光ファイバを分離し、及び投光部と受光部とを分離するようにし でもよい。第8図はこの透過型の検出ユニットの概略構成を示す図である。 光ファイバ71を投光用の第1の光ファイバとする。光ファイバ71の位置 は第5図の光ファイバ41と同様とし、その先端には投光部72を設ける。 又ブラインドクラックの位置を透過した光を受光するための受光部73、受 光用の第2の光ファイバ74を設ける。その他の構成は前述した実施の形態 と同様である。このように投光部と受光部とを分離すれば、投光した光のうちブラインドクラックが形成される位置を透過した光の光量を直接検出して、ブラインドクラックが正常に形成されているかどうかを検出できる。この場

合にはブラインドクラックが形成されていなければ透過量が多くなり、ブラインドクラックが形成されている部分では透過量が減少する。又先走り現象等の発生によりガラス基板50の端部に第7図(a),(b)に示すようなスクライブライン形成における異常が発生した場合には、制御不能な異常なクラックの発生箇所での光乱反射のレベルが高く、透過光として得られる受光レベルが大幅に低くなる。従って正常な透過光レベルの上下に閾値を設定しておくことによって、ブラインドクラック(垂直クラック)が形成されたときの正常な状態と上記の異常状態とを区別して認識することができる。

次に本発明の第3の実施の形態について説明する。第9図に示すように、
しーザ発振器と冷却ノズルと共に、検出ユニットを設けた支持台31をテーブルの下方に配置し、下方からブラインドクラックを形成するようにしてもよい。この場合であっても検出ユニットが小型であるため容易に下側に配置することができ、ガラス基板50の下側から第1の実施の形態を実施することで、ガラス基板50の下側からブラインドクラックBCが正確に形成されているかどうかを検出することができる。又第2の実施の形態に示すように検出ユニットの投光部と受光部を分離してもよい。

次に検出ユニット40の別の例について説明する。検出ユニット40は第 10図に示すように、光源としてレーザダイオード61を使用したものであってもよい。その出射光軸にレンズ62、偏光フィルタ63を介して偏光ビームスプリッタ64が配置される。偏光フィルタ63は特定の偏光方向の光のみを照射光とするためのものであり、偏光ビームスプリッタ64は偏光フィルタ63で選択された偏光方向のレーザ光をそのまま透過させ、これと垂直方向のレーザ光を反射させるものである。偏光ビームスプリッタ64の出射端側には前述した光ファイバ41が設けられている。又光ファイバ41から得られる反射光は偏光方向がランダムであるため、その反射光の一部は偏光ビームスプリッタ64で分離された光はミラー65、レンズ66を介して受光素子であるフォトダイオード

1.5

20

25

67に入射されるように構成されている。又フォトダイオード67に得られる信号はアンプ68により増幅され、判別部(DET)69に与えられる。判別部69はウィンドウコンパレータを含んで構成され、ウィンドウコンパレータに設定される閾値Vref1,Vref2の中間のレベルかどうかによって、プラインドクラックの形成状況の良否を判別するものである。ここでレーザダイオード61、レンズ62、偏光フィルタ63、偏光ビームスプリッタ64はセンサ用の光ファイバに光を入射する投光部を構成しており、偏光ビームスプリッタ64、ミラー65、レンズ66、フォトダイオード67は反射された光を光ファイバを介して受光する受光部を構成している。

第11図は、スクライブ装置に続けて、ブレイク装置を組み込んだガラス 基板50の分断自動化ラインの一例を示した単板のガラス基板の自動分断ライン100の概略模式図である。

このガラス基板自動分断ライン100は、ガラス基板50を収納したカセットを装着したカセットローダー101と、カセットローダー101から引き出されたガラス基板50を載置した後、載置されたガラス基板50を位置決めするコンペア102と、ガラス基板50をスクライブする本発明のスクライブ装置103と、スクライブラインが形成されたガラス基板50を散置した後、位置決めするコンペア104と、2分化したテーブルにより構成され、そのうちの少なくとも1つのテーブルを下方に回転移動させることによりガラス基板50を撓ませてガラス基板50をスクライブラインに沿って分断するプレイク装置105と、分断されたガラス基板(以下、複数枚に分断された各ガラス基板を、ガラス基板508という)をガラス基板自動分断ライン100外に搬出する搬出コンペア106とを備えている。又ガラス基板自動分断ライン100の各所には、各状態のガラス基板50を供給し搬送するための給材ロボットR1、搬送ロボットR2~R5が設けられている。

次いでこのガラス基板自動分断ライン100の動作について説明する。カセットローダー101のカセット内に収納されたガラス基板50が、給材ロ

ボットR1により取り出され、取り出されたガラス基板50がコンペア10 2上に位置決めされる、その後、ガラス基板50は、搬送ロボットR2によって保持され、スクライブ装置103内に搬送される。

搬送されたガラス基板50は、スクライブ装置103内のテープル上に載 置される。スクライブ装置103では、上述したように、ガラス基板50に 対してあらかじめ設計されたラインに沿ったブラインドクラックBCが形成 される。このスクライブ装置103において、ガラス基板50の表面に、所 定のプラインドクラックBCが良好に形成されなかった場合には、検出ユニット40からNG信号が出され、スクライブ装置103の動作が停止される と共に、異常発生を知らせる警報が発せられる。

一方スクライブ装置103において、ガラス基板50の表面上にブラインドクラックBCが良好に形成された場合には、ガラス基板50は搬送ロボットR3によって保持されて、コンベア104上に載置される。

コンペア104上に載置されたガラス基板50は、コンペア104の前方 側において位置決めされ、搬送ロボットR4が、ガラス基板50のブライン ドクラックBCが2分化したテーブル間の中央に位置するようにプレイク装 置105内に搬送する。プレイク装置105では、プラインドクラックが形成されるガラス基板50をプラインドクラックに沿って分断する。プレイク 装置105で複数枚に分断されたガラス基板50Bは搬送ロボットR5によ って搬出コンペア106上に載置される。

尚、別のライン構成として、検出ユニット40からNG信号が発生された場合には、所定のプラインドクラックBCが形成されなかったガラス基板50をライン100から自動搬出させる機器構成を採用することも可能である。これにより全自動運転が可能となる。

25 尚、実施の形態では、脆性材料基板としてガラス基板について説明してきたが、脆性材料基板としては単板のガラス基板だけでなく、半導体ウェハ、液晶パネルとされる貼り合わせガラス基板やセラミック基板等が含まれる。

又貼り合わせ基板としてのマザー液晶パネル基板、PDP(プラズマディスプレイパネル)、LCOS、プロジェクタ基板等が含まれ、これらの種々の脆性材料基板の加工に本発明を適用することができる。また、導光路として光ファイバを用いて説明してきたが、これに限らず、光導波路フィルム等を用いることができる。

産業上の利用の可能性

本発明では、プラインドクラックを光学的に検出しているため、検出ユニットを小型化することができ、プラインドクラックが正常に形成されたかどうかを容易に識別することができる。本発明によるスクライブ装置とスクライプ方法は、フラットパネルディスプレイ(以下、FPDという)に使用されるガラス基板、半導体ウェハ等の脆性材料基板をスクライブする際に使用することができる。このスクライブ装置及びスクライブ方法を自動分断ラインに適用することによって、プラインドクラック(垂直クラック)のライン(スクライブライン)が正常に形成された脆性材料基板のみを次のプレイク工程へ搬送し、分断することができる。

請求の範囲

1. 脆性材料基板の表面におけるスクライブ予定ラインに沿って、該脆性材料基板の軟化点よりも低い温度で連続して加熱しつつ、その加熱領域の近傍の領域を連続して冷却することにより、前記スクライブ予定ラインに沿ってブラインドクラックを形成する脆性材料基板のスクライブ装置であって、

前記脆性材料基板の表面における冷却領域に近接したプラインドクラック の形成領域との間で光が伝播されるように配置された導光路と、

前記導光路を介して光を出射する投光部と、

前記投光部から前記導光路を介して出射されプラインドクラックによって 反射された光を前記導光路を介して受光する受光部と、

前記受光部より得られた受光レベルを判別する判別部と、を具備することを特徴とする脆性材料基板のスクライブ装置。

- 前記導光路が光ファイバであることを特徴とする請求項1記載の脆性
 材料基板のスクライブ装置。
 - 3. 前記投光部の前記導光路は、出射光が前記脆性材料基板の下面で一度 反射してからプラインドクラックに入射するように配置されていることを特 徴とする請求項1記載の脆性材料基板のスクライブ装置。

20

5

10

- 4. 前記判別部は、所定の反射光量レベルの上下に閾値を設け、その閾値を逸脱するか否かによってプラインドクラックの形成状態の良否を判別することを特徴とする請求項1記載の脆性材料基板のスクライブ装置。
- 25 5. 脆性材料基板の表面におけるスクライブ予定ラインに沿って、該脆性 材料基板の軟化点よりも低い温度で連続して加熱しつつ、その加熱領域の近 傍の領域を連続して冷却することにより、前記スクライブ予定ラインに沿っ

てプラインドクラックを形成する脆性材料基板のスクライブ装置であって、

前記脆性材料基板の表面における冷却領域に近接したプラインドクラック の形成領域との間で光が伝播されるように配置された第1, 第2の導光路と、 前記第1の導光路を介して光を出射する投光部と、

前記投光部から前記導光路を介して出射されプラインドクラックを透過した光を前記第2の導光路を介して受光する受光部と、

前記受光部より得られた受光レベルを判別する判別部と、を具備することを特徴とする脆性材料基板のスクライブ装置。

- 10 6. 前記導光路が光ファイバであることを特徴とする請求項5記載の脆性 材料基板のスクライブ装置。
 - 7. 前記投光部の前記導光路は、出射光が前記脆性材料基板の下面で一度 反射してからプラインドクラックに入射するように配置されていることを特 徴とする請求項5記載の脆性材料基板のスクライブ装置。
 - 8. 前記判別部は、所定の反射光量レベルの上下に閾値を設け、その閾値を逸脱するか否かによってプラインドクラックの形成状態の良否を判別することを特徴とする請求項5記載の脆性材料基板のスクライブ装置。

20

15

5

- 9. 脆性材料基板の表面におけるスクライブ予定ラインに沿って、該脆性材料基板の軟化点よりも低い温度で連続して加熱しつつ、その加熱領域の近傍の領域を連続して冷却することにより、前記スクライブ予定ラインに沿ってブラインドクラックを形成する脆性材料基板のスクライブ方法であって、
- 25 前記脆性材料基板の表面における冷却領域に近接したプラインドクラック の形成領域に向けて導光路を介して光を出射し、

プラインドクラックから得られる反射光を前記導光路を介して受光し、

15

20

その受光レベルに基づいてプラインドクラックの形成状態を確認しつつス クライブすることを特徴とする脆性材料基板のスクライブ方法。

- 10. 前記導光路に光ファイバを用いることを特徴とする請求項9記載の 5 脆性材料基板のスクライブ方法。
 - 11. 前記プラインドクラックの形成領域に向けて導光路を介して光を出射するに際し、出射光が前記脆性材料基板の下面で一度反射してからプラインドクラックに入射することを特徴とする請求項9記載の脆性材料基板のスクライブ方法。
 - 12. 脆性材料基板の表面におけるスクライプ予定ラインに沿って、該脆性材料基板の軟化点よりも低い温度で連続して加熱しつつ、その加熱領域の近傍の領域を連続して冷却することにより、前記スクライプ予定ラインに沿ってプラインドクラックを形成する脆性材料基板のスクライプ方法であって、

前記脆性材料基板の表面における冷却領域に近接したプラインドクラック の形成領域に向けて第1の導光路を介して光を出射し、

プラインドクラックを透過した光を第2の導光路を介して受光し、

その受光レベルに基づいてプラインドクラックの形成状態を確認しつつス クライブすることを特徴とする脆性材料基板のスクライブ方法。

- 13. 前記導光路に光ファイバを用いることを特徴とする請求項12記載の脆性材料基板のスクライブ方法。
- 25 14.前記プラインドクラックの形成領域に向けて導光路を介して光を出射するに際し、出射光が前記脆性材料基板の下面で一度反射してからプラインドクラックに入射することを特徴とする請求項12記載の脆性材料基板の

スクライブ方法。

- 15. 請求項1に記載の少なくとも1台の脆性材料基板のスクライブ装置 と、少なくとも1台のプレイク装置を備えたことを特徴とする脆性材料基板 5 の自動分断ライン。
 - 16. 請求項5に記載の少なくとも1台の脆性材料基板のスクライブ装置と、少なくとも1台のプレイク装置を備えたことを特徴とする脆性材料基板の自動分断ライン。

補正書の請求の顧用

補正書の請求の範囲[2004年6月24日(24.06.04)国際事務局受理:出願 当初の請求の範囲1、5,9及び12は補正された;出願当初の請求の範囲2―4,6― 8、10,11,13及び14は取り下げられた。;他の請求の範囲は変更なし。(4頁)]

1. (補正後) 脆性材料基板の表面におけるスクライプ予定ラインに沿って、該脆性材料基板の軟化点よりも低い温度で連続して加熱しつつ、その加熱領域の近傍の領域を連続して冷却することにより、前記スクライブ予定ラインに沿ってプラインドクラックを形成する脆性材料基板のスクライブ装置であって、

光を出射する投光部と、

前記投光部からの出射光が前記脆性材料基板の下面で反射してから前記脆性材料基板の表面における冷却領域に近接したプラインドクラックの形成領域へ入射するように配置された光ファイバと、

前記投光部から前記光ファイバを介して出射され、プラインドクラックによって反射された光を前記光ファイバを介して受光する受光部と、

前記受光部より得られる受光信号が予め設定された閾値内か否かを判別するウィンドウコンパレータを備える判別部と、を具備し、

- 15 前記判別部の出力に基づいてプラインドクラックの形状状態を確認することを特徴とする脆性材料基板のスクライブ装置。
 - 2. (削除)
- 20 3. (削除)

10

- 4. (削除)
- 5. (補正後) 脆性材料基板の表面におけるスクライブ予定ラインに沿って、該脆性材料基板の軟化点よりも低い温度で連続して加熱しつつ、その加熱領域の近傍の領域を連続して冷却することにより、前記スクライブ予定ラインに沿ってプラインドクラックを形成する脆性材料基板のスクライブ装置

であって、

光を出射する投光部と、

前記投光部からの出射光が前記脆性材料基板の下面で反射してから前記脆性材料基板の表面における冷却領域に近接したプラインドクラックの形成領域へ入射するように配置された第1の光ファイバと、

前記投光部から出射されてプラインドクラックを透過した光が入射される 第2の光ファイバと、

前記第2の光ファイバより得られる透過光を受光する受光部と、

前記受光部より得られる受光信号が予め設定された閾値内か否かを判別す 10 るウィンドウコンパレータを備える判別部と、を具備し、

前記判別部の出力に基づいてプラインドクラックの形状状態を確認することを特徴とする脆性材料基板のスクライブ装置。

6. (削除)

15

- 7. (削除)
- 8. (削除)
- 20 9. (補正後) 脆性材料基板の表面におけるスクライブ予定ラインに沿って、該脆性材料基板の軟化点よりも低い温度で連続して加熱しつつ、その加熱領域の近傍の領域を連続して冷却することにより、前記スクライブ予定ラインに沿ってブラインドクラックを形成する脆性材料基板のスクライブ方法であって、
- 25 光を光ファイバを通して前記脆性材料基板の下面で反射させて前記脆性材料基板の表面における冷却領域に近接したプラインドクラックの形成領域に入射し、

前記プラインドクラックで反射した光を前記光ファイバを通して受光し、 その受光した光量を信号に変換し、

受光した信号が予め設定された閾値内か否かを判別することによりプラインドクラックの形成状況の良否を確認しつつスクライブすることを特徴とする脆性材料基板のスクライブ方法。

10. (削除)

11. (削除)

10

15

20

12. (補正後) 脆性材料基板の表面におけるスクライプ予定ラインに沿って、該脆性材料基板の軟化点よりも低い温度で連続して加熱しつつ、その加熱領域の近傍の領域を連続して冷却することにより、前記スクライプ予定ラインに沿ってプラインドクラックを形成する脆性材料基板のスクライプ方法であって、

光を第1の光ファイバを通して前記脆性材料基板の下面で反射させて前記 脆性材料基板の表面における冷却領域に近接したプラインドクラックの形成 領域に入射し、

前記プラインドクラックを透過した光を第2の光ファイバを介して受光し、 受光した光量を信号に変換し、

受光した信号が予め設定された閾値内か否かを判別することによりプラインドクラックの形成状況の良否を確認しつつスクライブすることを特徴とする脆性材料基板のスクライブ方法。

25 13. (削除)

14. (削除)

15. 請求項1に記載の少なくとも1台の脆性材料基板のスクライブ装置と、少なくとも1台のブレイク装置を備えたことを特徴とする脆性材料基板の自動分断ライン。

5

16. 請求項5に記載の少なくとも1台の脆性材料基板のスクライブ装置と、少なくとも1台のブレイク装置を備えたことを特徴とする脆性材料基板の自動分断ライン。

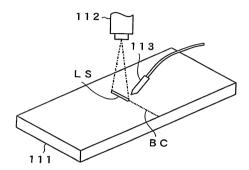
条約第19条(1)に基づく説明書

請求の範囲第1項は、投光部からの出射光を光ファイバを介して脆性材料基板 に入射し、脆性材料基板の下面で反射してから脆性材料基板の表面におけるプラ インドクラックの形成領域に入射することを明確にし、又受光部より得られた受 光信号をウィンドウコンパレータによって閾値内かどうかを判別し、この閾値内 であれば正常なプラインドクラックが形成されていることを確認することを明確 にしたものである。

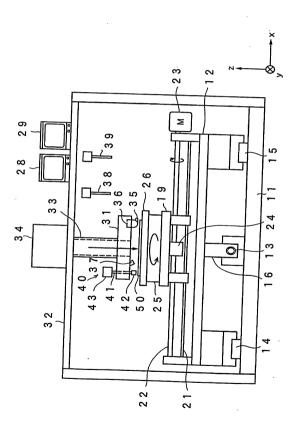
請求の範囲第5項は、投光部から光ファイバを介して光を脆性材料基板に導き、その下面で反射した光を脆性材料基板の表面におけるプラインドクラックの形成状況に入射するように配置し、プラインドクラックを透過した光を第2の光ファイバを介して受光し、受光部より得られた受光信号をウィンドウコンパレータによって閾値内かどうかを判別し、この閾値内であれば正常なプラインドクラックが形成されていることを確認することを明確にしたものである。

請求の範囲第9項は請求の範囲第1項の発明を方法として表現したものである。 請求の範囲第12項は請求の範囲第5項の発明を方法の発明として表現したも のである。 1/9

第1図

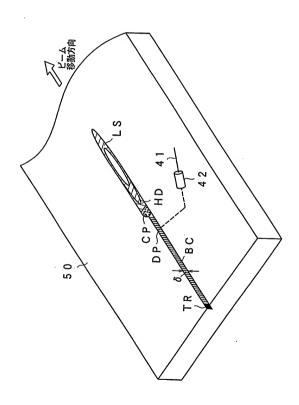


2/9 第2図



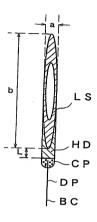
3/9

第3図

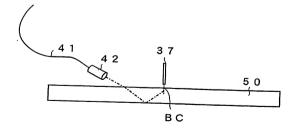


4/9

第4図



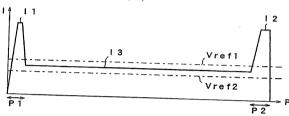
第5図



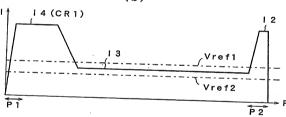
5/9

第6図

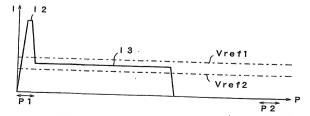




(b)

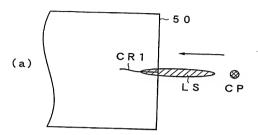


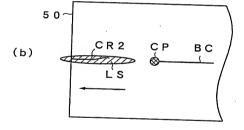
(c)





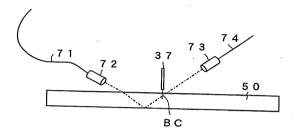
第7図



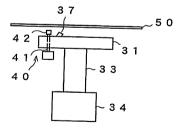


7/9

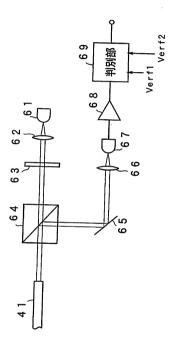
第8図



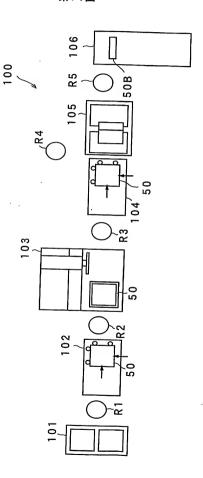
第9図



8/9 第10図



第11図



INTERNAT VAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP2004/000084

A CLAS	CITICATION OF CITI PROTECTION						
A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl ⁷ B28D5/00, C03B33/09							
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC B. FIELDS SEARCHED							
							
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl ⁷ B28D1/00-7/04, C03B33/00-33/14 Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched							
Documenta Jits Koka	nents are included Shinan Koh Toroku Koh	0 1994-2004					
Electronic o	data base consulted during the international search (na						
	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	into the data data and ,	e practicaore, con	ren terms useu,			
							
Category*	Citation of document, with indication, where a			Relevant to claim No.			
Y	Co., Ltd.), 15 May, 2001 (15.05.01), Par. No. [0003] (Family: none)	i Diamond Indu	strial	1-16			
Y	JP 2000-281375 A (NEC Corp. 10 October, 2000 (10.10.00), Par. No. [0040] (Family: none)		1-16				
A	JP 8-509947 A. (Fonon Technology ltd.), 22 October, 1996 (22.10.96), Page 9, line 29 to page 10, line 4 & WO 93/020015 A1			1-16			
Furthe	er documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family	y annex.				
Special	categories of cited documents:	"T" later document pub	lished after the inter	national filing date or			
conside	red to be of particular relevance document but published on or after the international filing	understand the principle	ciple or theory unde	e application but cited to dying the invention			
date		considered novel or	ular relevance; the cl cannot be consider	laimed invention cannot be ed to involve an inventive			
cited to	ent which may throw doubts on priority claim(s) or which is establish the publication date of another citation or other	step when the docur	ment is taken alone	laimed invention cannot be			
"O" docume	reason (as specified) ant referring to an oral disclosure, use, exhibition or other	considered to involv	ve an inventive sten	when the document is			
"P" docume than the	ent published prior to the international filing date but later priority date claimed	combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art document member of the same patent family					
Date of the actual completion of the international search 14 April, 2004 (14.04.04)		Date of mailing of the international search report 27 April, 2004 (27.04.04)					
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office		Authorized officer					
vapanese ratent Office		BEST AVAILABLE COP					
Facsimile No.		Telephone No.	J.				

国際, 极告				
		国際出願番号	PCT/JP20	004/00008
A. 発明の Int. C	属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) 1' B28D5/00 C03B33/	0 9		
B. 調査を	行った分野			
調査を行った	最小限資料 (国際維許公籍 (I PC))			
Int.	C1' B28D1/00-7/04 C0:	3B33/00-33/	/14	
日本国委員日本国登員日本国委員日本国委員日本国実用	外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 新寮公報 期実用新案公報 1922-1996年 1971-2004年 株実用新業公報 1994-2004年 新案登録公報 1996-2004年			
国際調査で使	用した電子データベース (データベースの名称	、調査に使用した用語		
C. 関連する	ると認められる文献			
引用文献の				関連する
カテゴリー* Y	から はらい はんりゅう	ときは、その関連する	箇所の表示	請求の範囲の番号
1	JP 2001-130921 A (社) 2001. 05. 15, 【00	三星ダイヤモンド) 0 3 】(ファミ!	工業株式会 リーなし)	1-16
Y	JP 2000-281375 A (0. 10. 10, 【0040】(フ	日本電気株式会社 ァミリーなし)	200	1-16
A	JP 8-509947 A (フォノド) 1996. 10. 22, 第9頁 & WO 93/020015 A	1980日紀 441日	リミテッ) 頁第 4 行	1-16
□ C棚の締き	にも文献が列挙されている。			
		パテントファ	ミリーに関する別	紙を参照。
「E」国後にを主いの際になった。の際には主いののでは、「L」のでは、「L」のでは、「L」のでは、「L」のでは、「O」	(のある文献ではなく、一般的技術水準を示す i目前の出願または特許であるが、国際出顧日 表されたもの 悪に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 け他の特別な理由を確立するために引用する 由を付す) る開示、使用、展示等に言及する文献 日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願	出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの「&」同一パテントファミリー文献		
	14.04.2004	国際調査報告の発送日	27. 4. 20	004
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁 (ISA/JP) 郵便番号100-8915		特許庁審査官 (権限の 紀本 孝	>ある職員)	3P 8815
東京都	千代田区徽が関三丁目 4番 3 号	電話番号 03-35	91-1101	